

**Список основных публикаций официального оппонента
Ивана Сергеевича Васильевского по теме диссертации**

- [1] S.V. Gudina , Yu.G. Arapov, A.P. Savelyev, V.N. Neverov, S.M. Podgornyykh, N.G. Shelushinina, M.V. Yakunin, K. Rogacki, I.S. Vasil'evskii, A.N. Vinichenko, Quantum Hall effect in n-InGaAs/InAlAs metamorphic nanoheterostructures with high InAs content, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 440, P. 10 (2017)
- [2] И.С. Васильевский, С.С. Пушкарёв, М.М. Грехов, А.Н. Виниченко, Д.В. Лаврухин, О.С. Коленцова, Особенности диагностики метаморфных наногетероструктур InAlAs/InGaAs/InAlAs методом высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии в режиме ω -сканирования, *ФТП*, Т. 50, Вып. 4, С. 567 (2016)
- [3] Г.Б. Галиев, И.С. Васильевский, Е.А. Климов, А.Н. Ключков, Д.В. Лаврухин, С.С. Пушкарёв, П.П. Мальцев, Особенности фотолюминесценции НЕМТ-наногетероструктур с составной квантовой ямой InAlAs/InGaAs/InAs/InGaAs/InAlAs, *ФТП*, Т. 49, Вып. 2, С. 241 (2015)
- [4] G.B. Galiev, I.S. Vasil'evskii, E.A. Klimov, S.S. Pushkarev, A.N. Klochkov, P.P. Maltsev, M.Yu. Presniakov, I.N. Trunkin, A.L. Vasiliev, Electrophysical and structural properties of the composite quantum wells $\text{In}_{0.52}\text{Al}_{0.48}\text{As}/\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{In}_{0.52}\text{Al}_{0.48}\text{As}$ with ultrathin InAs inserts, *Journal of Materials Research*, Vol. 30, P. 3020 (2015)
- [5] G.B. Galiev, I.S. Vasil'evskii, E.A. Klimov, S.S. Pushkarev, A.N. Klochkov, P.P. Maltsev, M.Yu. Presniakov, I.N. Trunkin, A.L. Vasiliev, Effect of (1 0 0) GaAs substrate misorientation on electrophysical parameters, structural properties and surface morphology of metamorphic HEMT nanoheterostructures InGaAs/InAlAs, *Journal of Crystal Growth*, Vol. 392, P. 11 (2014)
- [6] Г.Б. Галиев, И.С. Васильевский, Е.А. Климов, А.Н. Ключков, Д.В. Лаврухин, С.С. Пушкарёв, П.П. Мальцев, Применение спектроскопии фотолюминесценции для исследования метаморфных наногетероструктур $\text{In}_{0.38}\text{Al}_{0.62}\text{As}/\text{In}_{0.38}\text{Ga}_{0.62}\text{As}/\text{GaAs}$, *ФТП*, Т. 48, Вып. 7, С. 909 (2014)
- [7] Г.Б. Галиев, С.С. Пушкарёв, И.С. Васильевский, Е.А. Климов, А.Н. Ключков, П.П. Мальцев, Влияние разориентации подложки (100) GaAs на электрофизические параметры и морфологию поверхности метаморфных НЕМТ наногетероструктур $\text{In}_{0.7}\text{Al}_{0.3}\text{As}/\text{In}_{0.75}\text{Ga}_{0.25}\text{As}/\text{In}_{0.7}\text{Al}_{0.3}\text{As}$, *ФТП*, Т. 48, Вып. 1, С. 67 (2014)

- [8] Г.Б. Галиев, С.С. Пушкарёв, И.С. Васильевский, О.М. Жигалина, Е.А. Климов, В.Г. Жигалина, Р.М. Имамов, Исследование влияния напряженных сверхрешеток, введенных в метаморфный буфер, на электрофизические свойства и атомное строение МНЕМТ наногетероструктур InAlAs/InGaAs, *ФТП*, Т. 47, Вып. 4, С. 510 (2013)
- [9] В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, Н.А. Юзеева, И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, Замороженная фотопроводимость и подвижности электронов в структурах с квантовой ямой $\text{In}_{0.52}\text{Al}_{0.48}\text{As}/\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}/\text{In}_{0.52}\text{Al}_{0.48}\text{As}/\text{InP}$, *ФТП*, Т. 47, Вып. 7, С. 927 (2013)
- [10] G.B. Galiev, I.S. Vasil'evskii, S.S. Pushkarev, E.A. Klimov, R.M. Imamov, P.A. Buffat, B. Dwir, E.I. Suvorova, Metamorphic InAlAs/InGaAs/InAlAs/GaAs HEMT heterostructures containing strained superlattices and inverse steps in the metamorphic buffer, *Journal of Crystal Growth*, Vol. 366, P. 55 (2013)
- [11] Г.Б. Галиев, С.С. Пушкарёв, И.С. Васильевский, Е.А. Климов, Р.М. Имамов, Исследование свойств новых конструкций метаморфного буфера InAlAs на подложках GaAs с распределенной компенсацией упругих деформаций, *ФТП*, Т. 47, Вып. 7, С. 990 (2013)
- [12] И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, А.Л. Кванин, С.С. Пушкарёв, М.А. Пушкин, Взаимосвязь конструкции метаморфных наногетероструктур InAlAs/InGaAs с содержанием InAs в активном слое 76–100% с морфологией их поверхности и электрофизическими свойствами, *ФТП*, Т. 45, Вып. 9, С. 1203 (2011)